PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE on Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Under the Paper Corter

Ming-Yang Chao

10/604,860

08/22/2003

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

Group Art Unit

First Named Inventor

Application Number

Filing Date

			Examiner Name				
Total Number of	MTKP0031USA						
ENCLOSURES (check all that apply)							
	claration(s) equest ent Request ure Statement fority g Parts/	Assignm (for an A Drawing Licensin Petition Provisio Power of Change Address Termina Reques	nent Papers Application) (s) g-related Papers to Convert to a nal Application of Attorney, Revocation of Correspondence	on [After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):		
	SIGNATU	RE OF APPLI	CANT, ATTORNE	Y, OR AC	GENT		
Firm or Individual name	Winston Hsu, Reg. No.: 41,526						
Signature	Winten Han						
Date	Signature Vinton Hail Date \$ 29/2003						
CERTIFICATE OF MAILING							
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date:							
Typed or printed name	Typed or printed name						
Signature				Date			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

SEP 0 3 2003 SEP 0 3 2003 SEP 0 3 2003 SEP

PTO/SB/17 (01-03)

Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

First Named Inventor Ming-Yang Chao

Examiner Name

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00

First Named Inventor Ming-Yang Chao

Examiner Name

Art Unit

Attorney Docket No. MTKP0031USA

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)				FEE CALCULATION (continued)					
Check Credit card Money Other None				3. ADDITIONAL FEES					
Check Credit card Order Order			<u>Large</u> l	Entity ₁	Small	Entity			
Deposit A	Account:			Fee			Fee	Fee Description	
Deposit Account	50-0801			Code	***		(\$)		Fee Paid
Number	<u> </u>			1051	130	2051		Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account	posit North America International Patent Office			1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
Name The Commissi	ioner is autho	orized to: (check all that ap	ply)	1053	130	1053		Non-English specification	
	(s) indicated b		verpayments	1812		1812	•	For filing a request for ex parte reexamination	
	• •	e(s) during the pendency of	this application	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
=		elow, except for the filing			1.840*	1805	1.840*	Requesting publication of SIR after	ļ
to the above-id]	,,,,,,,		,	Examiner action	
		CALCULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC FI				1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
Large Entity S				1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
Fee Fee	Fee Fee	Fee Description	Fee Paid	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
Code (\$) 1001 750	Code (\$) 2001 375	Utility filing fee		1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
	2001 373	Design filing fee	\vdash	1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
1002 530	2002 103	Plant filing fee	—	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1003 320	2003 200	Reissue filing fee	\vdash	1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1004 750	2004 373	Provisional filing fee		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
1005 160				1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00				1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional		
2. EXTRA	CLAIM FEE	S FOR UTILITY AN	D REISSUE	: 1	1.300	2501) Utility issue fee (or reissue)	
		Fee from Extra Claims below			470	2502		5 Design issue fee	
Total Claims		0** = X] =	1503	630	2503	3 315	5 Plant issue fee	
Independent Claims	-:	3** = X] =	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
Multiple Depe	ndent]=	1807	50	180	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity				1806	180	180		Submission of Information Disclosure Stmt	
Fee Fee Code (\$)	Fee Fee Code (\$)			8021	40	802	:1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18	2202	9 Claims in excess of 20		1809	750	280	9 37	5 Filing a submission after final rejection	
1201 84	2201	42 Independent claims in		I				(37 CFR 1.129(a))	
1203 280		40 Multiple dependent cla	•	1810	750	281	0 37	5 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims over original patent		1801	750	2801	37	5 Request for Continued Examination (RCE)	 		
1205 18	2205	9 ** Reissue claims in e and over original pa		1802	900	1802	90	 Request for expedited examination of a design application 	
[0.000]			Othe	r fee (sı	pecify)				
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00			*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00						

SUBMITTED BY						(Complete	(if applicable)
Name (Print/Type)	Winston Hsu	/		Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature		/1/	undo		u_	Date	8/29/200

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
duction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:							
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy YES	Attached? NO		
092100570	Taiwan, R.O.C.	01/10/2003		7			
		!					

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



rus rus rus



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛, 其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

西元 2003 年 01 月 10 日 請 日

Application Date

5

ZE ZE

092100570

Application No.

申 聯發科技股份有限公司

Applicant(s)

Director General



2003 發文日期: 西元 Issue Date

09220263790 發文字號:

Serial No.





申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄 日	由本局填言	^{±)} 發明專利說明書
	中文	將資料寫入一光學儲存媒體之方法
發明名稱	英 文	A METHOD FOR WRITING DATA ONTO AN OPTICAL STORAGE MEDIUM
	姓名(中文)	1. 趙銘陽
-	姓 名 (英文)	1. Chao, Ming-Yang
∢明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 新竹縣竹東鎮中興路四段九七0號七樓
	住居所 (英文)	1.7F, No. 970, Sec. 4, Chung-Hsing Rd., Chu-Tung Town, Hsin-Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 聯發科技股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. MediaTek Inc.
Ξ	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
請人 (共1人)	(營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	1.1F, No. 13, Innovation Road 1, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 蔡明介
	代表人(英文)	1.Tsai, Ming-Kai
	TERNIST LIG	



四、中文發明摘要 (發明名稱:將資料寫入一光學儲存媒體之方法)

(一)、本案代表圖為:第 1 圖
 (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:
 10 步驟 12 步驟 14 步驟 16 步驟

六、英文發明摘要 (發明名稱: A METHOD FOR WRITING DATA ONTO AN OPTICAL STORAGE MEDIUM)

A method for writing data onto an optical storage medium using an optical storage device. The method includes following steps: providing an LFM waveform to the optical storage device, wherein the EFM waveform contains a previous land, a current pit, and a next land; choosing a set of write strategy parameters from a plurality of sets of write strategy parameters stored in a memory

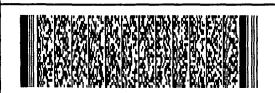




四、中文發明摘要 (發明名稱:將資料寫入一光學儲存媒體之方法)

六、英文發明摘要 (發明名稱:A METHOD FOR WRITING DATA ONTO AN OPTICAL STORAGE MEDIUM)

according to lengths of the previous land, the current pit, and the next land; generating a write reriod waveform according to the chosen set of write strategy parameters; and driving a pickup with the write period waveform, so as to write data onto the optical storage medium.



一、本案已向	•		
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先
		無	
· · · · · · · ·	. ··		
-、□主張專利法第二十五	· 條之一第一項優	· 先權:	
申請案號:			
日期:		無	
三、主張本案係符合專利法	:第二十個第一百	1 第一卦伯圭ポ	□第二款但書規定> 期間
	コイー(水水・ウ	八山小 水一百以	
日期:	· 다마 el		
四、□有關微生物已寄存於 寄存國家:	(四外:		
奇仔幽寒: 寄存機構:		無	
寄存日期:		•	
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存於	会國內(本局所指	定之寄存機構):	
寄存機構:		無	
寄存日期: 寄存號碼:		7115	
可仔號碼: □熟習該項技術者易於	·獲得,不須寄存	•	

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

本發明提供一種將資料寫入一光學儲存媒體之方法,尤指一種依據一 EFM波形之一前一平坦區、一目前凹洞區及一後一平坦區之資訊來將資料寫入一光學儲存媒體之方法。

先前技術

一光學儲存裝置(如 CD燒錄機或 DVD燒錄機等)於儲





五、發明說明 (2)

存 資 料 至 一 光 學 儲 存 媒 體 (如 CD光 碟 或 DVD光 碟 等) 時 , 會 將 該 資 料 利 用 該 光 學 儲 存 裝 置 之 一 編 碼 器 (Encoder) 轉換為該光學儲存媒體之儲存格式,於目前習知技術 中,此種光學儲存媒體之儲存格式通常為 RLL(Run-Length Limited)調變,例如一八對十四調變波 形 (Eight-to-Fourteen Modulation Waveform, EFM Waveform), 該 EFM波形係將欲儲存於該光學儲存媒體上 之資料以不同時間長度之方波來代表,以CD為例,該方 波之每一脈衝及脈衝間的距離均為三倍 EFM基準週期 (EFM Base Frequency) 至十一倍 EFM基準週期之間之長 度 , 而 該 EFM波 形 則 用 來 作 為 該 光 學 儲 存 裝 置 將 資 料 燒 錄 至 該 光 學 儲 存 媒 體 之 依 據 。 當 資 料 儲 存 於 該 光 學 儲 存 媒 體上時,係利用該光學儲存媒體上長度不一之複數個平。 坦區(Land)及凹洞區(Pit)來代表該資料之內容,而 該平坦區及凹洞區之長度則剛好對應於該EFM波形之波形 長度,利用此一對應關係,則該光學儲存裝置可以將資 料儲存至該光學儲存媒體上。

而於實際應用上,該光學儲存裝置係利用一組寫入 策略參數(Write Strategy Parameter)來將該EFM波形 轉換成用來驅動其一光學讀寫頭(Pickup)之寫入時間 . 度波形。對可抹除碟片而言,當該光學儲存裝置未寫 入資料時(也就是抹除之前寫入之訊號使之處於平坦區 時),該寫入時間長度波形係處於一消除態(Erase





五、發明說明 (3)

Power),當該光學儲存裝置欲寫入資料時(也就是處於凹洞區時),該寫入時間長度波形則處於一基準態 (Bias Power)且依序包含有複數個脈衝,該脈衝係使該寫入時間長度波形自該基準態切換至一寫入態 (Write Power),而該寫入策略參數則是用來定義於不同之平坦區或凹洞區的條件下,該等脈衝之長度及間距的狀態。

於習知技術中,寫入策略參數之定義通常係採用1T 策略,也就是說該寫入時間長度波形中之該等脈衝的週 期 是 以 一 倍 該 EFM基 準 週 期 為 準 , 然 而 隨 著 光 學 儲 存 媒 體 之烧錄技術的進步,能夠以更快的速度將資料燒錄至一 无 學 儲 存 媒 體 的 光 學 儲 存 裝 置 陸 續 出 現 (例 如 32倍 速 · 48倍速之光碟燒錄機),這使得該 EFM基準週期之長度愈 來愈短,在此狀況之下,造成於該寫入時間長度波形中 每一個脈衝〔即位於寫入態〕之後伴隨的間隔〔即位於 基準態)的長度過短,由於位於兩個脈衝之間的基準態 間隔係用來讓該光學儲存媒體表面上的化學材料得以冷 卻以形成正確儲存資料所需之凹洞,故因高速燒錄而造 成之基準態間隔長度過短將會使得冷卻時間不足而產生 資料儲存失真的問題。為了解決此一 1 T策略的問題,習 知技術中提出了一種 2T策略 (請參閱 Orange Book Part [I. Volume 3), 由於利用 2T策略之該寫入時間長度波 形 中 之 該 等 脈 衝 的 週 期 是 以 二 倍 該 EFM基 準 週 期 為 準 , 因 此該脈衝及其間之間隔的長度均得以延長,也因此使得





五、發明說明(4)

該光學儲存媒體表面上之化學材料於每次被該脈衝蝕刻後能夠有足夠的時間可以冷卻以形成正確之凹洞,而解決了1T策略的問題。

但是,由於其於決定 自是,對抗 所揭露的 2T策略,由於其於決 所揭露的 2T策略,由於其於決 所揭露的 2T策略,由於其於區 影時僅不是 一目前凹光學的 一目前凹光學的 一日前 2 大 一日前 3 是 一日前 3 是

發明內容

因此本發明之主要目的在於提供一種據一 EFM波形之一前一平坦區、一目前凹洞區及一後一平坦區之資訊來,資料寫入一光學儲存媒體之方法,以解決上述習知的問題。





五、發明說明 (5)

根據工學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術。

一名與一個學術學的學術學的學術,

一名與一個學術學的學術,

一名與一個學術學的學術,

一名與一個學術,

一名與一個學術,
一名與一個學術,

一名與一個學術





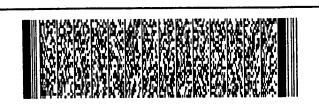
五、發明說明(6)實施方式

本發明係為使用一光學儲存裝置將資料寫入一光學儲存媒體之方法,其中該光學儲存裝置包含有一記憶體及一光學讀寫頭,而該記憶體中則儲存有複數組寫策。 略參數,請注意,於本發明之應用中,該光學儲存裝置可以為一光碟燒錄機(CD Burner),此時該光學儲存媒體可以為一可重覆寫入式光碟片(CD-RW),此外,該光學儲存裝置亦可以為一數位多用途光碟燒錄機(DVDBurner),而該光學儲存媒體則可以為一可記錄式數位多用途光碟片(DVD-RW),又於以下之實施例中將使用一入對十四調變波形為例,然而在不影響本發明之實施的情形下,使用其他RLL調變波形之例子亦屬於本發明之涵蓋範圍。

請參閱圖一,圖一中顯示本發明將資料寫入一光學儲存媒體之方法的流程圖,其包含有以下步驟:步驟 10:提供一八對十四調變波形至該光學儲存裝置,該八對十四調變波形包含有一前一平坦區(Previous Land)、一目前凹洞區(Cu'rrent Pit)以及一後一平坦 [(Next Land);

步驟 12: 依據該前一平坦區、該目前凹洞區以及該後一平坦區之波形長度,從該記憶體中所儲存之複數組寫入





五、發明說明 (7)

策略參數中選取一組相對應之寫入策略參數;

步驟 14: 依據該組被選取之寫入策略參數,產生一寫入時間長度波形;

步驟 16: 利用該寫入時間長度波形驅動該光學讀寫頭來將對應於該八對十四調變波形之資料寫入該光學儲存媒體。

其中該八對十四調變波形(亦即 EF M波形)如同前面所述,相對於該光學儲存媒體上用來代表所儲存之資料的複數個被蝕刻之凹洞區(Pit)及未被蝕刻之平坦區與大型區(Land),該 EF M波形亦分別包含有複數凹洞區及平坦區與大型區,舉例來說,該凹洞區可用該 EF M波形中之低準區外位來代表,而該平坦區則可用該 EF M波形中之低準值的來代表。亦如同前述,該 EF M波形之每一凹洞區及平坦區期之形長度均介於三倍 EF M基準週期至十一倍 EF M基準週期之間且均為該 EF M基準週期至十一倍 EF M基準週期之間且均為該 EF M基準週期的整數倍。針對該光學儲存媒體上每一個目前正欲被蝕刻的凹洞區來說,其均有該 EF M波形上相對應之一目前凹洞區後方之一後一平坦區與該目前凹洞區後方之一後一平坦區。

本發明之方法與習知技術中決定寫入策略參數的方. 最大的不同處,即於上述步驟 12中除了依據該目前凹洞區之波形長度之外,同時亦參考該前一平坦區及該後一平坦區之波形長度來從該記憶體中所儲存之複數組寫





五、發明說明 (8)

接下來將說明前述之步驟 12中選取該組寫入策略參數的方法,請參閱圖二中顯示本發明之 2T寫入策略參數的示意圖。於本發明之較佳實施例中,本發明係提供一種以 2T策略為基準來定義寫入策略參數的方法,也就是說,該寫入時間長度波形中之該等脈衝的週期是以二倍該 EFM基準週期 6 是 11倍基準週期 7 (即 117)之目前凹洞區的 EFM波形為例。在此情形下,本發明之方法所定義之寫入策略參數則如圖二中之寫入時間長度波形所示,將詳如下。

本發明之方法係定義一第一參數di,第一參數d代表





五、發明說明 (9)

自該目前凹洞區之前緣至該寫入時間長度波形之第一個 脈衝之前緣的延遲(Delay),且規定該寫入時間長度波 形之第一個脈衝之後緣係對齊於該目前凹洞區之前緣向 後二倍基準週期 T之處;一第二參數β,第二參數β代 表自該寫入時間長度波形之第一個脈衝之後緣至該第一 個脈衝之後一脈衝之前緣的延遲;複數個重覆脈衝參數 α 2、α 3、α 4、…,重覆脈衝參數α 2、α 3、α 4、…分別 代表該寫入時間長度波形中除了第一個脈衝及最後一個 脈衝之外其他脈衝之長度,且規定於該寫入時間長度波 形中除了第一個脈衝及最後一個脈衝之外的其他脈衝當 中,任何連續之二脈衝之前緣之間的長度等於基準週期 T 之二倍;一第三參數 dm,第三參數 d代表自該目前凹洞區 之後緣向前二倍基準週期T之處至該寫入時間長度波形之 最後一個脈衝之前緣的延遲;一第四參數α ",第四參數 α 代表該寫入時間長度波形之最後一個脈衝之長度;以 及一第五參數db,第五參數d則代表自該目前凹洞區之後 緣向前一倍基準週期T之處至該寫入時間長度波形切換回 消除態PE之處之延遲。請注意,前述之複數個重覆脈衝 参数α 2° α 3° α 4° ··· 係可為彼此相等之數值,亦可為 彼此未必相等之數值,此係為因應不同應用之設計選 擇。

依照上述所定義之各個寫入策略參數,則圖二中之該寫入時間長度波形之其他各項特徵均可得知,例如該





五、發明說明 (10)

寫入時間長度波形之第一個脈衝之長度 α 條等於二倍基準週期 T之長度減去第一參數 d_1 (亦即 $\alpha_1=2T-d_1$),而該寫入時間長度波形中除了第一個脈衝及最後一個脈衝之外的其他脈衝當中,任何一個脈衝之後緣與其下一個脈衝之前緣之間的延遲條等於二倍基準週期 T之長度 (亦即 $\beta_2=2T-\alpha_2$),又該寫入時間長度波形之最後一個脈衝之後緣至該寫入時間長度波形切換回消除態 PE之處之延遲條等於第五參數 d_1 如 d_2 所得之值(亦即 d_3 而 d_4 一倍基準週期 T之長度減去第三參數 d_4 而 d_4 一 d_4 一 d_4 一 d_4 。

請參閱圖三中顯示圖一中本發明之方法於步驟 12選取寫入策略參數的流程圖,其中於該記憶體中參數 d 及第二參數 β 以 该數 a 重覆參數 a 和 g x a 4 x 以及複數個第三參數 d m x 第四參數 a 和 g x a 4 x 数 d b 。則該方法另包含有以下步驟:步驟 20:從該門區、及該後一平坦區之波形長度,從該第一平坦區及該目前凹洞區之波形長度,從該第一參數 d 中選取一相對應之第一參數 β i;





五、發明說明(11)

步驟 24: 依據該目前凹洞區之波形長度,從該等重覆脈衝參數群組中選取一組相對應之重覆脈衝參數群組,亦即複數個重覆脈衝參數α 2° α 3° α 4° ···;

步驟 26:依據該目前凹洞區及該後一平坦區之波形長度,從該等第三參數 dm 選取一相對應之第三參數 dm, 並依據該目前凹洞區之波形長度,從該等第四參數 am 與 理取一相對應之第四參數 am, 同時依據該目前凹洞區及該後一平坦區之波形長度,從該等第五參數 dm 選取一相對應之第五參數 db;

步驟 28: 以被選取之第一參數 d \ 第二參數 β \ 该重覆胚衡參數群組、第三參數 d \ 第四參數 α 以及第五參數 d \ α 超成被選取之該組寫入策略參數。





五、發明說明 (12)

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變與修飾,皆屬於本發明專利之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖示之簡單說明

圖一為本發明之將資料寫入一光學儲存媒體之方法的流程圖。

圖二為本發明之 2T寫入策略參數的示意圖。

圖三為圖一中步驟 12選取寫入策略參數之方法的流程圖。

圖示之符號說明

步驟 10、12、14、16

步驟 20、22、24、26、28



1. 一種使用一光學儲存裝置將資料寫入一光學儲存媒體之方法,該光學儲存裝置包含有一記憶體及一光學讀寫頭 (Pickup) ,該記憶體中儲存有複數組寫入策略參數,該方法包含有以下步驟:

提供一 RLL調變波形至該光學儲存裝置,該 RLL調變波形包含有一前一平坦區 (Previous Land) 、一目前凹洞區 (Current Pit) 以及一後一平坦區 (Next Land);

依據該前一平坦區、該目前凹洞區以及該後一平坦區之波形長度,從該記憶體中所儲存之複數組寫入策略參數中選取一組相對應之寫入策略參數;

依據該組被選取之寫入策略參數,產生一寫入時間長度波形;以及

利用該寫入時間長度波形驅動該光學讀寫頭來將對應於該RLL調變波形之資料寫入該光學儲存媒體。

2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該RLL調變波形具有一基準週期(EFM Base Period),且當該光學儲存裝置未寫入資料時,該寫入時間長度波形係處於一消除態(Erase Power),當該光學儲存裝置欲寫入資料時,該寫入時間長度波形則處於一基準態(Bias Power)且依序包含有複數個脈衝,該脈衝係使該寫入時間長度波形自該基準態切換至一寫入態(Write Power)。





3. 如申請專利範圍第 2項所述之方法,其中該複數組寫入策略參數包含有複數個第一參數及複數個第二參數,各該第一參數代表自該目前凹洞區之前緣至該寫入時間長度波形之第一個脈衝之前緣的延遲(Delay) ,各該第二參數代表自該寫入時間長度波形之第一個脈衝之後緣至該第一個脈衝之後一脈衝之前緣的延遲,該方法另包含有以下步驟:

依據該前一平坦區及該目前凹洞區之波形長度,從該等第一參數中選取一相對應之第一參數;以及依據該前一平坦區及該目前凹洞區之波形長度,從該等第二參數中選取一相對應之第二參數。

5. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中該等寫入策

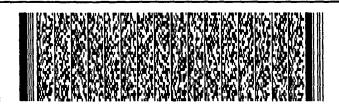


依據該目前凹洞區及該後一平坦區之波形長度,從該等第三參數中選取一相對應之第三參數;

件據該目前凹洞區之波形長度,從該等第四參數中選取 一相對應之第四參數;以及

依據該目前凹洞區及該後一平坦區之波形長度,從該等第五參數中選取一相對應之第五參數。

- 6. 如申請專利範圍第 3項所述之方法,其中該寫入時間長度波形之第一個脈衝之後緣係對齊於該目前凹洞區之前緣向後二倍該基準週期之處。
- 7. 如申請專利範圍第 3項所述之方法,其中該寫入時間長度波形之第一個脈衝之長度係等於二倍該基準週期之 人度減去該被選取之第一參數。
- 8. 如申請專利範圍第4項所述之方法,其中屬於同一重



覆脈衝參數群組中之該等重覆脈衝參數係彼此相等。

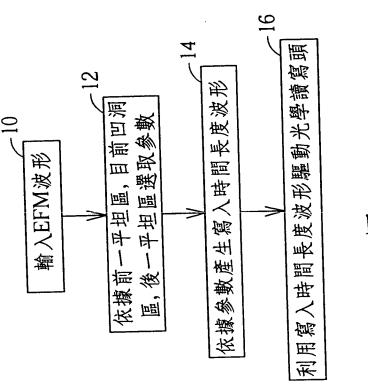
- 9. 如申請專利範圍第4項所述之方法,其中屬於同一重覆脈衝參數群組中之該等重覆脈衝參數未必彼此相等。
- 10. 如申請專利範圍第 2項所述之方法,其中於該寫入時間長度波形中除了第一個脈衝及最後一個脈衝之外的其他脈衝當中,任何一個脈衝之後緣與其下一個脈衝之前緣之間的延遲係等於二倍該基準週期之長度減去該脈衝之長度。
- 11. 如申請專利範圍第 5項所述之方法,其中該寫入時間長度波形之最後一個脈衝之後緣至該寫入時間長度波形切換回該消除態之處之延遲係等於該被選取之第五參數加上一倍該基準週期之長度減去該被選取之第三參數再減去該被選取之第四參數所得之值。
- 12. 如申請專利範圍第 2項所述之方法,其中該前一平坦區、該目前凹洞區、以及該後一平坦區之波形長度均為該基準週期之倍數並介於三倍該基準週期及十一倍該基準週期之間。
- 13. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中該消除態、該基準態、以及該寫入態之值係為預設值,且不會因為



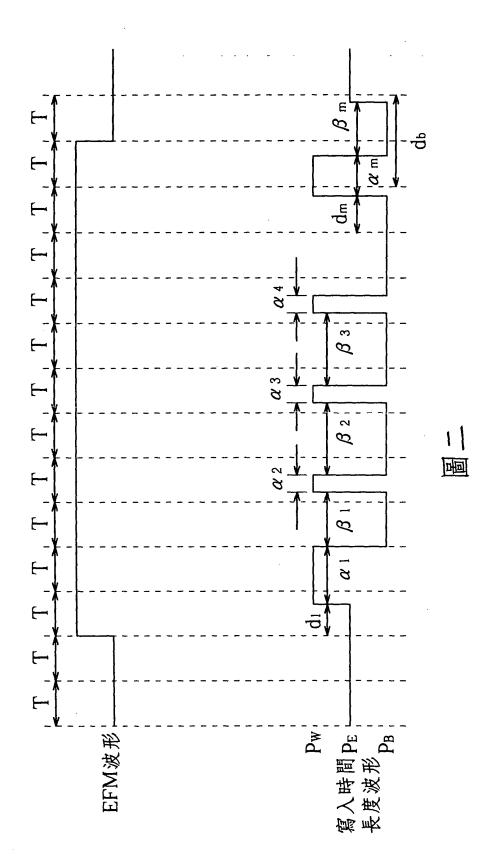
不同之RLL調變波形而有所不同。

- 14. 如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中該光學儲存裝置係為一光碟燒錄機 (CD Burner)。
- 15. 如申請專利範圍第 14項所述之方法,其中該光學儲存媒體係為一可重覆寫入式光碟片(CD-RW)。
- 16. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該光學儲存裝置係為一數位多用途光碟燒錄機(DVD Burner)。
- 17. 如申請專利範圍第 16項所述之方法,其中該光學儲存媒體係為一可記錄式數位多用途光碟片(DVD-R)。
- 18. 如申請專利範圍第 16項所述之方法,其中該光學儲存媒體係為一可重覆寫入式數位多用途光碟片 (DVD-RW)。
- 19. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該RLL調變波形係為一八對十四調變波形(Eight-to-Fourteen Modulation Waveform, EFM Waveform)。





<u>画</u>



*

